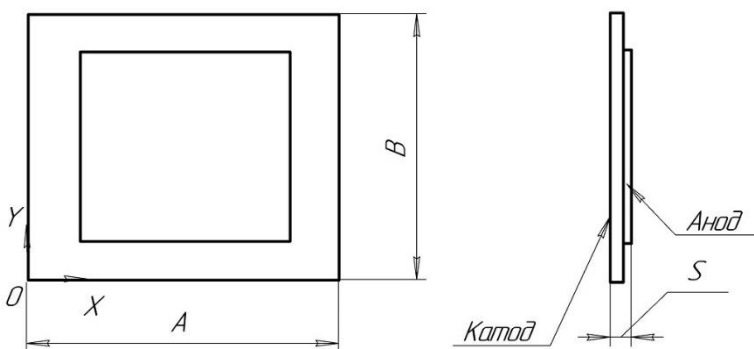



Кристалл ультрабыстрого диода с мягкой характеристикой обратного восстановления $U_{обр.} = 1200В$

Отличительные особенности:

- Эпитаксиально-планарная технология
- Низкое прямое падение напряжение
- Высокое быстродействие
- Малые значения обратных токов

Габаритные размеры


A	Размер кристалла, мм	8
B		8
S	Толщина кристалла, мм	0,35
Металлизация анода		Al-Ti
Металлизация катода		Ti-Ni-Ag
Пассивация		SiO ₂
Ширина линии скрайбирования, мм		0,06

Общее описание

Разрабатываемые кристаллы ультрабыстрых диодов предназначены для использования в выпрямителях высокой частоты, модуляторах, преобразователях, формирователях импульсов, ограничителях и других импульсных устройствах. Электрические характеристики подтверждаются тестированием 100 % кристаллов в нормальных условия ($T_A=25\text{ }^\circ\text{C}$) по основным параметрам : $U_{обр.}$, $I_{обр.}$, а также выборочным тестированием кристаллов на каждой пластине по параметру $U_{пр.}$ при номинальном значении прямого тока $I_{пр.ср.}$

Основные параметры и характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение параметра	Предельно-допустимый режим	
		не менее	не более
Постоянное обратное напряжение, В	$U_{обр.}$	-	1200
Постоянный прямой ток, А	$I_{пр.}$	-	100
Максимальная температура перехода, $^\circ\text{C}$	$T_{п. макс.}$	-	150
Время обратного восстановления, нс ($I_{пр}=1A, V_{обр}=30B, dI_{пр}/dt=200A/мкс$)	$T_{вос.обр}$	75	90


Электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Обозначение параметра	Норма параметра			Температура среды, °С
		не менее	типовое	не более	
Средний прямой ток (в составе корпуса у потребителя), А	$I_{пр.ср.}$	-	-	100	25±10
Постоянное прямое напряжение, В $I_{пр.ср.}=100$ А	$U_{пр.}$	-	1,9	2,1	
Постоянный обратный ток, мА ($U_{обр.} = 1200$ В)	$I_{обр.}$	-	0,01	0,04	
Постоянный обратный ток, мА ($U_{обр.} = 1200$ В)	$I_{обр.}$	-	1,5	2	125±10